



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种碳包铁钴纳米吸波材料的制备方法

文献类型: 专利

作者 韩拯, 李达, 耿殿禹, 刘先国, 王瀚, 谢志高, 孟辉, 龚文杰 and 张志东

发表日期 2009-10-28

专利国别 中国

专利类型 发明专利

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 本发明提供了一种宽频带,强吸收碳包铁钴纳米复合材料的制备方法。采用阴、阳极在工作气体下电弧放电产生等离子体的技术制备,工作气体为氩气,同时加入能提供碳元素且不引入除了C、H、O之外的杂质的有机物,阴极电极为钨等高熔点、难挥发金属,阳极靶材为铁钴合金,其中铁元素占合金原子比10%~90%。本发明制备的碳包铁钴纳米吸波材料是由纳米级铁钴合金外面包裹碳组成的纳米胶囊,碳壳层一方面作为防氧化层,增加了纳米复合物的稳定性;另一方面作为介电材料,与磁性铁钴内核复合,使得其吸波性能优于多数经典的铁氧体以及其他大多数纳米复合吸波材料...

公开日期 2009-10-28

语种 中文

专利申请号 CN101567224

源URL [<http://210.72.142.130/handle/321006/67526>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 韩拯, 李达, 耿殿禹, 刘先国, 王瀚, 谢志高, 孟辉, 龚文杰 and 张志东. 一种碳包铁钴纳米吸波材料的制备方法. 2009-GB/T 7714 10-28.

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

127

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

